

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭60—9184

50Int. Cl.4 H 01 S 3/096 識別記号

庁内整理番号 7377-5F

昭和60年(1985)1月18日 43公開

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

(2/

匈過バイアス電流検出回路

昭58-117381

22出 昭58(1983)6月29日

熊谷睦之 7000 明者

创特

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

願 人 富士通株式会社 伽出

川崎市中原区上小田中1015番地

理 人 弁理士 松岡宏四郎

埘

1. 発明の名称

過パイアス電流検出回路

2. 特許讃求の範囲

光出力を一定にするためのバイアス電流を制御 する自動光出力制御回路を備えた半導体レーザダ イオードにおいて、該半導体レーザダイオードに 流入するパイアス電流と基準電流を比較する電流 比較回路と、該半導体レーザダイオードの順方向 電圧と基準電圧を比較する電圧比較回路を設け、 前記自動光出力制御回路からのパイアス電流を前 記電流比較回路に入力し、該半導体レーザダイオ - ドの順方向進圧を前記電圧比較回路に入力し、 前記電流比較回路の出力と、前記電圧比較回路の 出力を論理積して、該半導体レーザダイオードの 劣化を検出するよう構成したことを特徴とする過 バイアス電旋校出回路。

- 3. 発明の辞細な説明
 - (a) 発明の技術分野

本発明は、半導体レーザダイオードの週パイ

アス電波検出回路に関する。

(b) 技術の背景

最近、半導体レーザダイオードは、その周辺 関連の技術進歩に伴い、光による通信を始め距離 測量・情報処理・ホログラフィ等の光発生器とし て利用する分野に用途が拡大されてきた。特に利 用分野の拡大に伴い、半導体レーザダイオードの 経年変化による特性劣化は、不特定多数のユーザ に与える影響が大となり、その信頼性について特 に重要視されている。その為、半導体レーザダイ オードの予防保守として、経年変化による劣化を 校出しアラーム信号を送出する機能が付加されて いる.

(c) 従来技術と問題点

一般に、半導体レーザダイオードの特性は、 第1図に示す如く横軸をバイアス電流値、縦軸を 光出力とした特性図において、その光出力はバイ アス電流を増加させるに従い、ある電流値から急 激に増大する特性を持っている。また、温度によ る依存性もあり、第1図は、半導体レーザダイオ ードの使用温度範囲内における任意の3点の温度をTa、To、Tbとした場合、Ta < To < Tbの関係を示し、温度が高くなればなる程一定の光出力を得るためには、バイアス電流を増大させねばならない。更に経年変化(劣化)によりバイアス電流が増大する現象もあり、これ等錯特性を考慮し、通常半将体レーザダイオードを駆動制御するには、バイアス電流を制御する自動光出力制御回路が設けられてある。

以下、従来の自動光出力制御回路(以下 APC回路と略称する)付きの半導体レーザダイオードについて説明する。第2図は従来の半導体レーザイオードの回路構成プロック図を示す。レーザー光発生器1で発生した光出力パワーを光検出する。その光出力パワーの一部を光検出する。その光出力パワーの一部を光検出りった光は出り、APC回路3に送出し、APC回路3に送出し、APC回路3に送出し、APC回路3に送出し、APC回路3に送出し、Tーが一定になるように、温度変化も含みレッサー光発生器1のバイアス電流の増減を制御駆動する。即ち、温度が上昇すればバイアス電流を増加

し、湿度が低下すればバイアス質流を抑制する働 きを行う。その為この周囲温度を監視して温度補 低を行うサーミスク4を設け、サーミスタ4から の温度情報をバイアス電流監視回路 5 を経由して APC回路 3 に送出し、その温度における適正なバ イアス電流を APC回路 3 で選択制御する。またぐ 温度の変動がなくともバイアス電流は経年変化に よる劣化によっても増加するため、バイアス電流 監視回路 5 は APC回路 3 よりパイアス電流の情報 を受け、感温素子であるサーミスタ 4 からの温度 **情報によるバイアス電流の温度補償を行い、経年** 変化により変化した余分のパイアス電流のみを取 り出し、予め設定されている限界値を越えた時に アラーム信号を送出し、アラーム信号出力端子 6 に出力して、半導体レーザダイオードの突然の破 壊を未然に防止するよう構成されている.

しかし、サーミスタ4の温度は半導体レーザダイオード自身の温度ではなく、間接的な周囲温度の情報であり、感温素子の感温特性による差と、取付位置の違いによる温度差を考慮すれば、サー

ミスタ4の指示温度と、半導体レーザダイオード 自身の温度との間に差異が生ずると共に、感温素 子による間接的な温度補償であるため、半導体レ ーザダイオードの経年変化による劣化を確実に検 出できない欠点を有していた。

. (4) 発明の目的

本発明は、この従来の欠点を解決することを 目的としている。

. (e) 発明の構成

ザダイオードの劣化を検出するよう構成した本発 明によって達成される。

即ち、半導体レーザダイオードの温度補償を半 導体レーザダイオード自身の順方向電圧で行うも ので、間接的な感温素子が不要となり、温度補償 が正確に把握でき、半導体レーザダイオードの経 年変化による劣化を確実に検出し、安全に予防保 守を行うことができる利点がある。

(1) 発明の実施例

-402-

以下本発明の一実施例について説明する。第 3 図は半導体レーザグイオードの特性図であり、 機軸にバイアス電流、縦軸上面に光出力、縦軸下 面は順方向電圧を示す。順方向電圧もバイアス電 流を増加させるに従い、ある電流値から急激に増 大する特性を持っている。また、温度による依存 性もあり、半導体レーザグイオードの使用温度を 囲内における任意の3点の温度をTa、To、Tbとし、 Ta < To < Tbの関係にあり、同一バイアス電流値に おいては、温度が高くなれば順方向電圧は低くな る性質を持っている。本特性図で、アラーム信号 を送出する検出バイアス電流値をIPmax 、温度To におけるその時の順方向電圧をVFo とし、温度上 界によりバイアス電流IFがIPmax に違した時の温 度Tbでの順方向電圧をVFb とすれば、

VFo > VFb '

であり、また、温度低下により温度Taにおけるその時の順方向電圧をVFa とすれば、

VPa > VFo

であっても、バイアス電流IPa は

IFa < IFmax

となる。ところが、経年変化による劣化によって バイアス電旋の増加分があった場合は、劣化時の パイアス電波をIFnoとし、その時の順方向電圧を VFnoとすれば、

IFno > IFmax

且つ

VFno > VFo

であり、順方向電圧の基準値は半導体レーザダイオード自身の温度特性により、その時点の順方向 電圧値を示し、即ち、順方向電圧で温度補償を行

ザダイオード自身の温度で温度補償ができ、間接的な周囲温度の情報とか、感温素子の感温特性による差や、取付位置の違いによる温度差を考慮する必要がなくなり、その温度補償を正確に行えるため、半導体レーザグイオードの劣化を確実に把握できる。

(6) 発明の効果

以上説明したように、自動光出力制御回路を 備えた半導体レーザダイオードに 2 個の比較回路 を設け、半導体レーザダイオードのバイアス電流 と順方向電圧を監視することにより、半導体レー ザダイオード自身で温度補償を行い、半導体レー ザダイオードの経年変化による劣化を確実に検出 できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は半導体レーザダイオードの特性図、第2 図は従来の半導体レーザダイオードの回路構成プロック図、第3 図は本発明の原理説明のための半導体レーザダイオード特性図、第4 図は本発明による半導体レーザダイオードの回路構成プロッ

っているので、バイアス電流の増加と共に、その 時点の順方向電圧をモニタし、バイアス電流と収 方向電圧の両基準値を越えたことを検出すれば、 半導体レーザダイオードの経年変化による劣化が 検出できる。

第4図は上記原理にもとすく本発明の半導体レーザグイオードの回路構成プロック図を示し、同一対象物は第2図と同一符号で示す。7は APC回路、8は電流比較回路、9は電圧比較回路、10は論理報回路を示す。

APC回路 7 がレーザー光発生器 1 を制御駆動するパイアス電流を電流比較回路 8 に入力し、 APC回路 7 よりその順方向電圧は電圧比較回路 9 に入力し、各々の基準電流または基準電圧と比較較られた場合は、電流と比較回路 8 と電圧比較回路 9 が共に作動し、論理積出路 10 が動作し、アラーム信号をアラーム信号出るの第 10 が動作し、アラーム信号をアラーム信号出る。以上本発明の回路構成にすれば、感温来子としてのサーミスタは不要となり、半導体レー

ク図を示す。

図面において、1はレーザー光発生器、2は光 検出器、6はアラーム信号出力協子、7は自動光 出力制御回路、8は電波比較回路、9は電圧比較 回路、10は論理積回路をそれぞれ示す。

代理人 弁理士 松岡宏四郎 完然





